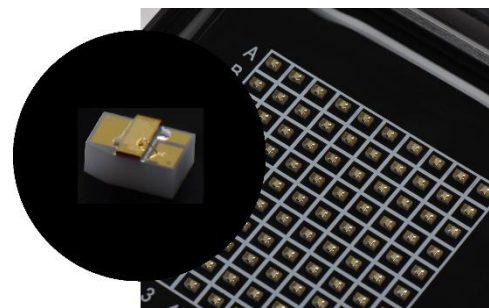


1.5 μm ゲインチップ (チップキャリア) AE5T310BY60P

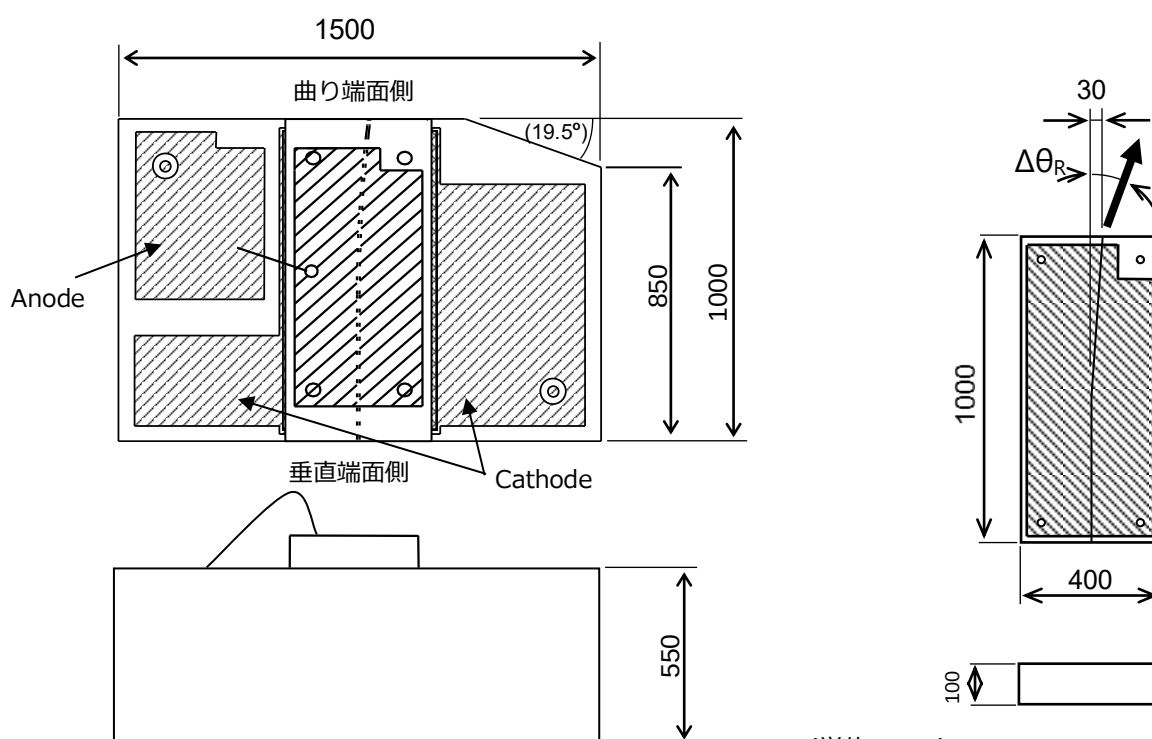
AE5T310BY60Pは、InGaAsP / InP で構成された1.5 μm 帯の外部共振器型レーザ用ゲインチップです。光ファイバ通信や光計測用の狭線幅広帯域波長可変光源などの光学利得媒体としてご利用いただけます。

特長

- ・広帯域波長可変：可変幅 > 100 nm (CL-band)
- ・高出力：レーザ発振出力 > 40 mW
- ・低スペクトルリップル
- ・垂直端面反射率：LR (6%)



外形寸法 (Unit : μm)



(単位 : mm)

ジャンクション・アップ ボンディング

絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
LD 順電流	I_F	500	mA
LD 逆電圧	V_R	2	V
動作ケース温度 ^{*1}	T_C	+15 to +45	°C
保存温度	T_{stg}	-40 to +85	°C
はんだ付け温度			
300°C		20	s
200°C		2	hour
120°C		100	hour
静電気放電 (ESD:人体モデル)	ESD	500	V

*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

*1 結露なきこと

電気的光学的特性 ($T_{LD} = 25^{\circ}\text{C}$)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
順電圧	V_F	$I_F = 200 \text{ mA}$, pulsed ($t_w = 50 \mu\text{s}$)	–	1.4	2.0	V
ASE 光出力	P_{ASE}	$I_F = 200 \text{ mA}$, pulsed ($t_w = 50 \mu\text{s}$)	1	5	–	mW
中心波長	λ_C	$I_F = 100 \text{ mA}$, pulsed ($t_w = 50 \mu\text{s}$)	1530	–	1590	nm
ASE リップル	M	$I_F = 100 \text{ mA}$, CW, $\lambda_C = 1560 \text{ nm}$	–	–	2.0	dB
曲り端面側出射角度	$\Delta\theta_R$	$I_F = 200 \text{ mA}$, CW	19	20	21	deg.
垂直端面側放射広がり角 (垂直方向)	θ_t^{NOR}	$I_F = 200 \text{ mA}$, CW, FAHM	15	20	25	deg.
垂直端面側放射広がり角 (水平方向)	θ_p^{NOR}	$I_F = 200 \text{ mA}$, CW, FAHM	17	20	23	deg.
曲り端面側放射広がり角 (垂直方向)	θ_t^{ANG}	$I_F = 200 \text{ mA}$, CW, FAHM	26	29	32	deg.
曲り端面側放射広がり角 (水平方向)	θ_p^{ANG}	$I_F = 200 \text{ mA}$, CW, FAHM	15	18	21	deg.

*長期信頼性の観点から気密封止での使用を推奨します。

反射率およびチップサイズ

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
曲り側反射率	R^{ANG}	CL-band	–	5×10^{-5}	10^{-4}	–
垂直側反射率	R^{NOR}	CL-band	5	6	7	%
チップ長		–	0.98	1.00	1.02	mm
チップ幅		–	0.38	0.40	0.42	mm
チップ厚		–	0.09	0.10	0.11	mm



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.
Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

SEMICONDUCTOR LASER

AVOID EXPOSURE
Invisible laser radiation is emitted from this aperture

DANGER

INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

OUTPUT POWER 500mW
WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μ m
CLASS IIIb LASER PRODUCT

Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan

アンリツ株式会社

センシング&デバイスカンパニー 営業部
<https://www.anritsu.com/sensing-devices>

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
TEL 046-296-6783 FAX 046-225-8390



お問い合わせURL
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/contact-us>

ご使用前に「光デバイス取扱い上の注意点」をお読みください。
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/guide/optdevices-handling>



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要になる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■記載事項はお断りなしに変更することがあります。